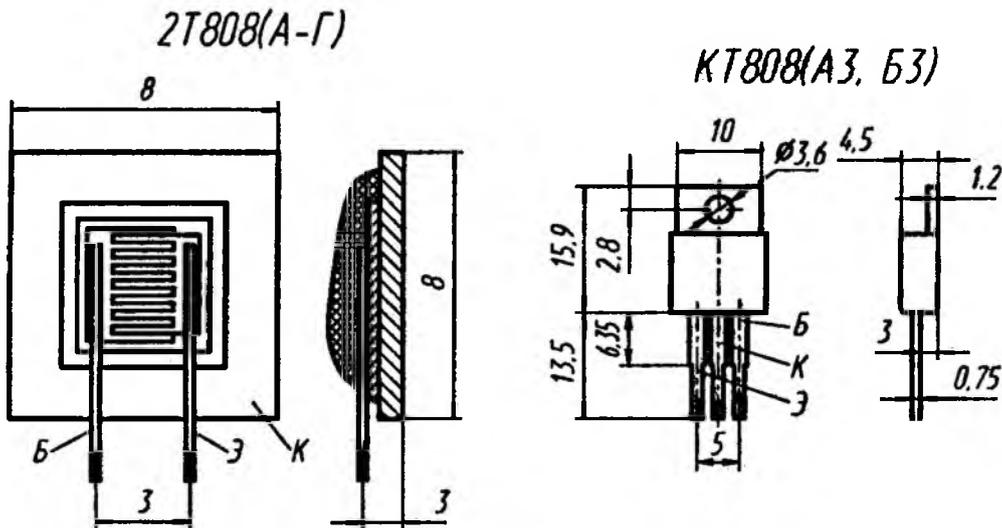


**2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808АМ, КТ808БМ,
КТ808ВМ, КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3**

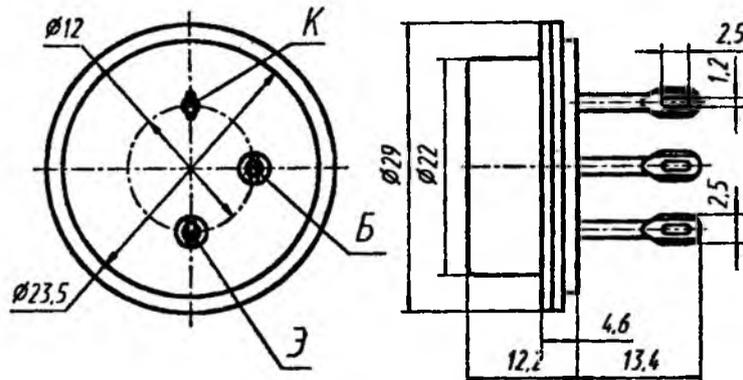
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ-КТ808ГМ металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами, КТ808А3, КТ808Б3 — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ-КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г, КТ808А3, КТ808Б3 — не более 2,5 г.

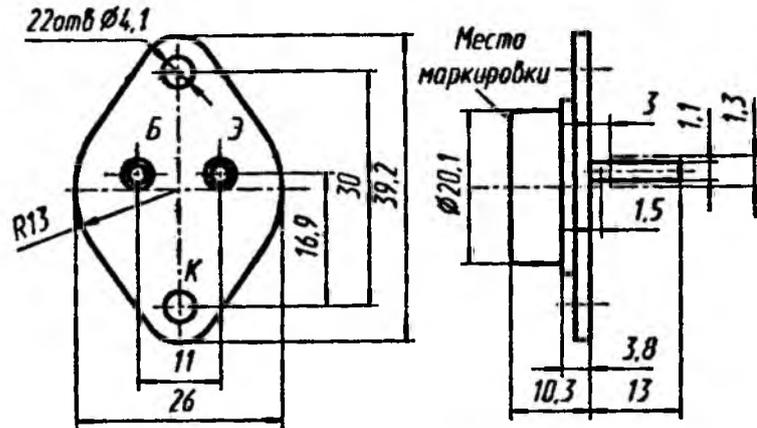
Изготовитель — завод «Искра», г. Ульяновск.



2Т808А, КТ808А



КТ808(АМ-ГМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при $U_{кэ} = 3$ В,

$I_k = 6$ А:

$T = +25$ °С 10...15*...50

$T = +125$ °С для 2Т808А и $T = +100$ °С
для КТ808А

10...20*...150

$T = -60$ °С

6...10*...50

КТ808АМ-КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3

при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 2$ А

20...125

Модуль коэффициента передачи тока на вы-
сокой частоте $f = 3,5$ МГц при $U_{кэ} = 10$ В,

$I_b = 0,5$ А, не менее

2,4

Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А,

$L = 25$ мГн, не менее:

КТ808АМ, КТ808А3

130 В

КТ808БМ, КТ808Б3

100 В

КТ808ВМ

80 В

КТ808ГМ

70 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

КТ808АМ-КТ808ГМ при $I_k = 6$ А, $I_b = 0,6$ А,
не более

1,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер

при $I_k = 6$ А, $I_b = 0,6$ А

1*...1,4*...

2,5 В

Время рассасывания при $U_{кэ} = 15$ В, $I_k = 6$ А,

не более

2 мкс

Обратный ток коллектор-эмиттер

при $R_{бэ} = 10$ Ом, не более:

$T = +25$ и -60 °С и $U_{кэ} = 200$ В для

2Т808А, 2Т808А-2 и $U_{кэ} = 120$ В для

КТ808А

3 мА

$T = +125$ °С, $U_{кэ} = 160$ В для 2Т808А,

2Т808А-2

20 мА

$T = +100$ °С $U_{кэ} = 120$ В для КТ808А

50 мА

Обратный ток коллектора $I_{CO8AM-KT808GM}$, KT808A3, KT808B3 при $U_{KЭ} = U_{KЭ R, МАКС}$, $T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, не более	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4\text{ В}$, не более	15 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10\text{ В}$, $f = 1\text{ МГц}$, не более	500 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{БЭ} = 10\text{ Ом}$, $T_n \leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	120 В
КТ808АМ, КТ808А3	130 В
КТ808БМ, КТ808Б3	100 В
КТ808ВМ	80 В
КТ808ГМ	70 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $t_n \leq 500\text{ мкс}$, $t_{\phi} \geq 30\text{ мкс}$, $U_{БЭ} = 2\text{ В}$ или $R_{БЭ} = 10\text{ Ом}$, $Q \geq 7$, $T_n \leq +100\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808АМ	250 В
КТ808БМ	160 В
КТ808ВМ	135 В
КТ808ГМ	80 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	4 В
КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3	5 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора	15 А

¹ При $T_n = +100...150\text{ }^{\circ}\text{C}$ постоянное и импульсное напряжение коллектор—эмиттер снижаются на 10% на каждые 10 $^{\circ}\text{C}$. Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_n + R_{T(n-K)}(P_K + P_Э),\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Постоянный ток базы	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
с теплоотводом:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	50 Вт
КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3	70 Вт
без теплоотвода 2Т808А, КТ808А	5 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	2 $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
Температура р-п перехода	+150 $^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808АМ—КТ808ГМ ...	-60... $T_K =$ = +125 $^{\circ}\text{C}$
КТ808А, КТ808А3, КТ808Б3	-60... $T_K =$ = +100 $^{\circ}\text{C}$

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А-2 не более +250 $^{\circ}\text{C}$, 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ—КТ808ГМ не более +275 $^{\circ}\text{C}$ в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А-2 составляет 300 В.